江苏多维科技发布
三轴高性能 TMR 线性磁场传感器

- TMR 传感器技术为三维磁场测量实现超低噪声和超高灵敏度，具备小型封装，适用于高精度的工业类和生物医药类传感器应用

美通社美国加利福尼亚州圣何塞和中国江苏省张家港市 2016 年 3 月 29 日电 专业的隧道磁阻 (TMR) 磁传感器领先供应商江苏多维科技有限公司 (MultiDimension Technology Co., Ltd., MDT) 日前发布了 TMR23xx 系列的三轴高性能隧道磁阻（TMR） 线性磁场传感器。这一产品系列的设计指标可以满足广泛的应用要求，可以针对 +/-500 Oe 大动态范围的工作环境，也可以实现高达 100mV/V/Oe 的超高灵敏度和 150pT/rtHz (@1Hz) 的超低噪声特性，同时具备尺寸仅为 4x4x2.5mm 的小型 LGA 封装。它们最适用于高端的工业类和生物医药类传感器应用、磁场的精确测量、精密的速度和位置测量、地磁检测、金属探测、无损探伤、磁通信，和三维磁成像等应用。

江苏多维科技有限公司董事长兼首席执行官薛松生博士表示：“MDT 全新的三轴高性能 TMR 传感器为高端传感器应用提供了更加便捷的多项功能。这些应用已经开始受益于 MDT 的 TMR 传感器技术的多种优势，包括杰出的低噪声、低功耗和高灵敏度特性，这是其他包括各向异性磁阻 (AMR)、巨磁阻 (GMR) 或霍尔效应等基于半导体的磁传感器技术所不能实现的。TMR23xx 系列在一个单独的小型封装或者模块中集成了三个 TMR 传感元件，用于 X/Y/Z 三维磁场测量。它们具备小尺寸、精确的 X/Y/Z 三轴安装定位、简化的电路设计，和更高的成本效益，是提升客户投资回报的最佳方案。基于 MDT 在 TMR 传感器设计和制造上的丰富经验，我们也可以提供定制的三轴传感器方案，以量身定制的方式满足客户的特殊需求。”

TMR23xx 系列产品一览

产品型号	电压 (V)	灵敏度 (mV/V/Oe)	电阻 (kOhm)	动态范围 (Oe)	噪声 (nT/rtHz @1Hz)	封装和尺寸
TMR2301	0-7	1	15	+/-500	100	LGA12L(4x4x2.5mm)
TMR2303		3	30	+/-150	30	LGA12L(5x5x2.5mm)
TMR2305		25	9	+/-10	2	LGA12L(5x5x2.5mm)
TMR2307		8	1.5	+/-30	1	LGA12L(7x7x2.5mm)
TMR2309		100	15	+/-8	0.15	模块(9.5x9.5x6mm)

MDT 是首家 TMR 传感器的批量供应商，可在多个产品系列供货。除 TMR 线性磁场传感器之外，MDT 还提供 TMR 磁开关、TMR 角度传感器、TMR 齿轮传感器和 TMR 磁图像传感器。MDT 同时提供综合性的服务选项，包括 TMR/GMR/AMR 传感器的定制设计、传感器制造的代工服务，和知识产权授权服务。

MDT 简介

多维科技创立于 2010 年，总部设在中国江苏省张家港，在中国上海、成都、宁波和美国加利福尼亚州圣何塞设有分公司。MDT 拥有多项独特的专利技术和最先进的制造能力，可批量生产高性能、低成本 TMR 磁传感器以满足最严格的应用需求。多维科技的核心管理团队由磁传感器技术和工程服务领域的业内精英和资深专家组成。在核心团队的带领下，MDT 致力于为客户带来更多附加值，并确保他们的成功。有关 MDT 详情，请访问：http://www.dowaytech.com/。

媒体联系人

刘劲峰，电邮：jinfeng.liu@dowaytech.com，电话：+1-650-275-2318（美国），+86-189-3612-1156（中国）

魏继烈，电邮：kevin.wei@dowaytech.com，电话：+86-189-3612-1160（中国）

消息来源 江苏多维科技有限公司